2007年3月

スピントランスファー効果による強磁性円盤中の磁気渦の運動

物質系専攻 56105 石田 俊樹 指導教員:大谷 義近(教授)

キーワード:磁性、スピン、ナノスケール、電気伝導、高周波測定

近年、スピン注入磁化反転や強磁性細線における磁壁の電流駆動など、伝導電子スピンと局在スピン の間に働くスピントランスファー効果に関する興味深い現象が観測されている[1]。一方、強磁性体はミク ロンサイズにまで微小化すると、表面磁荷による反磁場の寄与が支配的となるため、形状による磁区構造 の制御が可能となる。ミクロンサイズの強磁性体円盤では Fig. 1(a)のように磁化分布が円盤中心に対し 旋回する磁気渦構造が安定な磁気構造として出現する。磁気渦構造の中心では、交換エネルギーの増 大を防ぐために、吹き出し磁化と呼ばれる垂直磁化成分が現れる。先述のスピントランスファー効果は磁 化の空間変化に比例することが知られており、吹き出し磁化近傍では高効率な効果が期待される。我々 は磁気渦構造におけるスピントランスファー効果を、電気伝導測定から詳細に調べた。

Fig. 1(b)に、測定で用いた試料の電子顕微鏡写真を示す。試料は直径2 μmのパーマロイ(Py)強磁性 円盤であり、電気伝導測定および直流電流掃引のための非磁性端子を円盤に取り付けてある。これによ り、電流方向に対し縦方向に生じるプレーナーホール抵抗*R_{PHE}の*観測が可能となり、強磁性円盤の磁化 過程を高精度で調べることが出来る。Fig. 2(a)に、電流方向から45度に傾けた外部磁場を印加した場合 の*R_{PHE}の変化を示す。*また、差分法によるポアソン方程式による電流分布計算と、マイクロマグネティクス よる磁気渦構造の計算結果を組み合わせることにより、再現できることを確認した(Fig. 2(b))。



(b)



Fig. 1(a) 磁気渦構造の概略図(b) 作製試料の SEM 像



(b)数値計算を用いた RPHE 変化

磁気渦構造では、スピントランスファー効果に より、磁気渦が吹き出し磁化の方向と直流電流 方向に対してローレンツ型の力を受け、その大 きさは電流密度に比例することが理論的に指摘 されている(Fig. 3(a))[2]。そこで、電流端子に 直流電流を重畳し、*RPHE* 測定を行った。この 測定では、ジュール加熱による抵抗の増加の影 響をフィッティングし取り除くことで、直流電流を 重畳した場合でも高感度な磁化過程の検出が 可能である。Fig 3(b) は、直流電流を変化させ た場合の *RPHE*の変化である。ジュール加熱に よる抵抗増大の効果を取り除けば、電流に比例 した *RPHE*の変化が明瞭に求められる。

この直流電流に比例する抵抗変化から、磁気 渦の移動量 δ を算出すると、電流Iとの比例関 係 $\delta = a \times I$ で表せることがわかった。この結果 は、前述の理論を用いて、定量的に説明できる ことを確認した[3]。また、磁気渦の吹き出し磁 化の方向を制御した場合の実験も行い、理論 的予言どおりに渦の移動方向は磁化方向の反 転により逆転することも確認した。

次に、渦消失寸前の固定磁場を印加し、ス ピントランスファー効果による磁気渦構造 の影響を測定した結果をFig.4に示す。 I=-8.6 (mA)において、電流の掃引方向に対 し不加逆な*RpHe*の増加が観測された。増加値 は渦消失のものと一致するため、この*RpHE* は電流誘起による渦消失に対応しているこ とがわかる。また、直流電流の掃引方向を逆 にした測定を行い、その方向依存性も明らか にした。

さらに、Fig. 4 には、電流誘起による渦の消 失寸前にピーク構造が観測されている。この抵 抗変化は、単磁区構造の磁性体において観測 されるスピントランスファー効果により励起された スピン波励起に類似しているため、スピントラン スファー効果により励起されたスピン波の一種と 考えられる。



Fig. 3(a) 磁気渦構造に作用するスピントランスフ ァー効果 (b) 直流電流掃引による *R_{PHE}の変化。薄* 線は測定結果、黒線は電流に比例した成分を示して いる。



Fig. 4 渦消失寸前の固定磁場印加下の、直流電流 掃引による **R**_{PHE} の変化

このスピン波励起をより詳細に調べるため、我々はネットワークアナライザー等を用いた高周波測定を 行っている。磁気渦構造では、外部磁場により渦が円盤中心から移動した後、磁場を取り去ることにより 渦は有効質量を持つ粒子とみなされ、進行方向に垂直に加わるジャイロカにより螺旋運動中心へと緩和 していく。しかしながら、ある特定の周波数をもつ交流磁場などを印加すれば、ジャイロカはキャンセルさ れ、磁気渦が円盤中心を旋回し続ける共振状態になる[3]。

そこで、我々はコプラナーライン上にある強磁性円盤(半径 2、3 μm、厚さ 40 nm)に交流磁場をもった 信号を流し、コプラナーラインのインピーダンスの周波数特性をネットワークアナライザーを用いて測定す ることで、渦の共鳴周波数を調べた。その結果を Fig. 5(b)に示す。それぞれの円盤において、200 MHz 付近で磁気渦の共振によるものと考えられるインピーダンスの変化を観測した。これらの周波数は、理論 的に予想される磁気渦の共鳴周波数と定量的に一致することが確認された。



Fig. 5(a)磁気渦構造の共鳴現象 (b)磁気渦構造にお ける反射強度測定による高周波特性

- [1] A. Yamaguchi et al., Phys. Rev. Lett. 92, 077205 (2004).
- [2] J. Shibata et al., Phys. Rev. B. 73, 020403 (2006)
- [3] T. Ishida et al., Phys. Rev. B 74, 014424 (2006)
- [4] K. Y. Guslienko et al. J. Appl. Phys. 91, 10 (2006)